

삼성전자, 하반기 35나노 D램 양산

40나노급 보다 생산성 60% 향상 ... 하반기 PC 교체 수요도 기대

삼성전자가 2010년 하반기에 35나노급 D램 양산을 본격화한다.

삼성전자는 현재 35나노급 D램 개발에 집중하고 있으며, 하반기 중으로 양산체제에 돌입할 것이라고 밝혔다.

35나노급 D램은 40나노급보다 생산성이 60% 가량 높은 제품으로 경쟁기업들은 40나노급 제품을 공급하고 있는 상황이다.

조남성 전무는 2010년 반도체 시장 전망에 대해 “전반적인 시장 상황이 좋을 것으로 본다”며 “특히 하반기에는 PC 교체 수요 등으로 반도체 수요가 매우 강할 것”이라고 말했다.

용량 단위로 환산한 D램 생산량 증가율(Bit Growth) 기준으로 2010년 D램은 45-50%, 낸드플래시는 75-80%가량 성장할 것으로 내다봤다.

또 지속적으로 공정 고도화에 주력해 하반기에는 낸드플래시 중 30나노대 제품이 80% 이상을 차지할 것으로 예상했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2010/01/29>